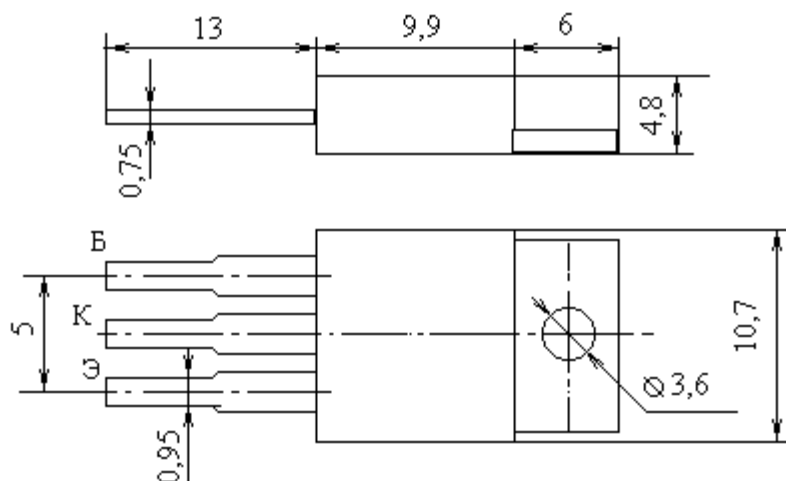


Транзисторы биполярные n-p-n большой мощности низкой и средней частоты



Название	КТ819Г
Материал	Si
$I_k \text{ max, A}$	10
$I_k \text{ и max, A}$	15
$U_{кэо гр}(U_{кэо, и max})[U_{кэг max}], \text{ В}$	80
$U_{эбо max}(U_{эбо, и max}), \text{ В}$	5
$P_k \text{ max}(P_k, \text{ ср max})(P_k, и max), \text{ Вт}$	60
при $T_k(T), \text{ C}$	25
$T_k \text{ max}(T \text{ max}), \text{ C}$	100
$h_{21э}(h_{21э})[S_{21} \text{ тип}]$	12
при $U_{кэ}(U_{кб}), \text{ В}$	[5]
$U_{кэ} \text{ нас, В}$	5
$I_{кб0}(I_{кэг})\{I_{кэо}\}, \text{ mA}$	2
$f_{гр}(f_{h21}), \text{ МГц}$	1
$S_k, \text{ пф}$	3
$S_э, \text{ пф}$	1000
$t_{выкл}(t_{рас})[t_{сп}], \text{ мкс}$	2.5
$R_T \text{ п-к}(R_T \text{ п-с}), \text{ C/Вт}$	1.67